

CONTENTS

A.P. Djotyan, E.M. Kazarian, Yu.V. Karakashian, A.S. Chirkinian Interband light absorbtion in $A^{III}B^V$ - type size - quantized semiconductor films.	67
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian. Media effect on charge carriers scattering in a thin semiconducting wire.	73
M.K. Balyan, K.T. Gabrielyan. The electron microscope moire pattern for weak deformed crystals.	82
A.P. Djotian, E.M. Kazarian, H.A. Sarkisian. The relativistic hydrogen atom.	90
V.M. Arutiounian, V.A. Gevorkyan, K.M. Gambaryan. Application of new approach to liquid-phase electroepitaxy for InSbAsBi layers and diod heterostructures growth.	94
A.L. Asatrian, A.L. Vartanian, A.A. Kirakosian. Mobility calculation of quas i- two - dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method.	101

Ա.Պ. Ջոթյան, Է.Մ. Ղազարյան, Յու.Վ. Կարակաշյան, Ա.Ս. Չիրկինյան. Լույսի միջգոտիական կլանումը $A^{III}B$ - տիպի բարակ քվանտացված կիսահաղորդչային թաղանթներում	67
Ա. Ա. Կիրակոսյան, Շ.Գ. Գասպարյան. Միջավայրի ազդեցությունը բարակ կիսահաղորդչային լարում լիցքակիրների խառնուրդային ցրման վրա	73
Մ.Կ.Բալյան, Կ.Թ.Գաբրիելյան. Թույլ դեֆորմացված բյուրեղների էլեկտրոնամանրադիտակային մուարի պատկերները	82
Ա.Պ. Ջոթյան, Է.Մ. Ղազարյան, Դ.Ա. Սարգսյան. Ջրածնի միաչափ ռեյատիվիստական ատոմ	90
Վ. Մ. Դարոթյունյան, Վ.Ա. Գևորգյան, Կ.Ս. Ղամբարյան. Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիայի նոր տարատեսակի կիրա- ռումը $InSbAsBi$ թաղանթների և նրանց հիման վրա դիողային հետերոկառուցվածքների աճեցման համար.	94
Ա.Լ. Ասատրյան, Ա.Լ. Վարդանյան, Ա.Ա. Կիրակոսյան. Քվազիերկչափ լիցքակիրների շարժունության հաշվարկը կիսահաղորդչային կառուցվածքներում էներգիական կորուստների մեթոդով.	101

СОДЕРЖАНИЕ

А.П. Джотян, Э.М. Казарян, Ю.В. Каракашян, А.С. Чиркинян. Межзонное поглощение света в размерно - квантованных полупроводниковых пленках типа $A^{III}B^V$	67
А.А. Киракосян, Ш.Г. Гаспарян. Влияние среды на примесное рассеяние носителей заряда в тонкой полупроводниковой проволоке	73
М.К. Балян, К.Т. Габриелян. Электронно - микроскопические картины муара слабдеформированных кристаллов	82
А.П. Джотян, Э.М. Казарян, А.А. Саркисян. Релятивистский двумерный атом водорода	90
В.М. Арутюнян, В.А. Геворкян, К.М. Гамбарян. Применение новой разновидности электрожидкостной эпитаксии для выращивания пленок $InSbAsBi$ и диодных гетероструктур на их основе	94
А.Л. Асатрян, А.Л. Вартанян, А.А. Киракосян. Расчет под- вижности квазидвумерных носителей заряда в полупровод- никовых структурах методом энергетических потерь.	101